

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Nguyên Hải

2. Ngày tháng năm sinh: 25/07/1968; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Căn hộ chung cư Trung Hòa, CCCT và Dịch vụ N04, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Căn hộ 1908, Tòa A, chung cư UDIC

COMPLEX N04, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0968116817;

E-mail: phamnguyenhai@hus.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 08,1998 đến tháng, năm 06,2022: Phó Trưởng Khoa Vật lý (đến 15/10/2021) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng Khoa Vật lý (đến 10/2021)

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 5583980

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 06 tháng 06 năm 1992, số văn bằng: A32774, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý Chất rắn; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

- Được cấp bằng TS [5] ngày 20 tháng 05 năm 1997, số văn bằng: No. 10702, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý Bán dẫn; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Tổng Hợp Amsterdam (Hà Lan)

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

1) Ứng dụng các kỹ thuật phổ cộng hưởng từ để xác định khối lượng hiệu dụng các hạt tải và nghiên cứu các tâm sai hỏng trong vật liệu SiC, GaN, GaNAs/GaAs;

2) Chế tạo, nghiên cứu tính chất màng mỏng trong suốt dẫn điện ZnO pha tạp Al, Ag, Si, Cu và khảo sát tính chất quang của vật liệu ZnO pha tạp Eu;

3) Nghiên cứu chế tạo để Raman tăng cường bề mặt trên cơ sở hạt nano kim loại quý và cấu trúc nano thấp chiều bán dẫn/kim loại quý để nhận biết các chất có nồng độ thấp định hướng ứng dụng trong y sinh và môi trường

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 5 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 61 bài báo khoa học, trong đó 31 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển đơn vị năm 2016	Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội	2016

2	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về thành tích đồng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất năm 2022	Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên	2022
---	--	--	------

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- **Mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy:** Đảm bảo yêu cầu của một giảng viên trong nhà trường theo các quy định ban hành. Tôi đã tham gia giảng dạy cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Vật lý, ngành Khoa học Vật liệu, Hệ Tài năng Vật lý và Chương trình tiên tiến quốc tế bằng tiếng Anh; tham gia giảng dạy Cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Vật lý Chất rắn, giảng dạy Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ bán dẫn (MSc Degree Program of Semiconductor Manufacturing) do Trường Đại học Yang Ming Chiaotung Đài Loan (NYCU, Trung Quốc) cấp bằng và thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)
- **Hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành:** Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của giảng viên
- **Năng lực giảng dạy:** Năng lực giảng dạy tốt, chuyên môn vững để giúp người học tiếp cận các kiến thức cơ bản và hiện đại, có trách nhiệm, tận tâm với công việc.
- **Ý kiến phản hồi của người học trong 3 năm gần nhất:** Mức đánh giá các môn giảng dạy và đào tạo đều cao hơn mức đánh giá trung bình của giảng viên toàn trường và của khoa Vật lý.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 23 năm 10 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

--

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2016 – 2017		1		1	132	30	132/293/202.5
2	2017 – 2018		1		2	180		180/342/202.5
3	2018 – 2019		1			180	30	210/382.3/202.5
03 năm học cuối								
4	2019 – 2020		1	1		180		180/322.3/202.5
5	2020 - 2021		2	1	2	180	105	285/648.3/189
6	2021 - 2022		2		2	180	165	345/693.3/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Hà Lan năm 1997

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài



- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/ CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/ CK2/ BSNT	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Văn Hiếu		X	X		05/2011 đến 11/2012	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	02/04/2013

2	Nguyễn Thị Thảo		X	X		05/2014 đến 12/2014	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	06/04/2015
3	Nông Ngọc Hồi		X	X		05/2014 đến 12/2015	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/03/2016
4	Trần Thị Ngọc Anh		X	X		04/2015 đến 12/2015	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/03/2016

5	Nguyễn Văn Sơn		X	X		04/2018 đến 12/2020	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	09/04/2021
---	----------------	--	---	---	--	------------------------	--	------------

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Xếp loại KQ
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu ZnO pha tạp chất thuộc nhóm nguyên tố đất hiếm	CN	QT-09-12, cấp Bộ	01/01/2009 đến 31/12/2022	Nghiệm thu ngày: 27/4/2010 Xếp loại: Khá
2	Ứng dụng laser chế tạo và nghiên cứu thuộc tính quang học phi tuyến của một số hạt nano kim loại quý	CN	QGTĐ-10-04, cấp Bộ	16/06/2010 đến 15/06/2012	Nghiệm thu ngày 1/11/2012 Xếp loại: Tốt
3	Nghiên cứu vật liệu cấu trúc kim loại/bán dẫn trên cơ sở vật liệu đồng oxit và khả năng ứng dụng	CN	CA.19.6A, cấp Bộ	01/11/2019 đến 01/11/2021	Nghiệm thu ngày 19/4/2022 Xếp loại: Xuất sắc

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								

1	Electron-paramagnetic-resonance study of silver-induced defects in silicon	4	Có	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI <i>IF: 4,06, Q1</i>	11	Vol.56 P.4614-4619	08/1997
2	Copper-related defects in silicon: Electron-paramagnetic-resonance identification	4	Có	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI <i>IF: 4,06, Q1</i>	20	Vol.56 P.4620-4625	08/1997
3	Isolated substitutional silver and silver-induced defects in silicon: An electron-paramagnetic-resonance investigation	4	Có	Materials Science Forum, ISSN:1662-9752	Có - Scopus	4	Vol.258 P.491-496	12/1997
4	Cảm biến nhiệt điện màng mỏng Bi-Te ứng dụng làm đầu thu bức xạ hồng ngoại	5	Không	VNU, Journal of Science, Mathematics-Physics, ISSN:2615-9341			Vol.5 P.12	01/1991

5	A low-cost self-made capacitance DLTS equipment	2	Không	Proceedings of The 4th Vietnam conference on Radio-Electronics			Vol.1 P.170	11/1992
6	The rate-window of the capacitance DLTS equipment using a double lock-in amplifier	2	Không	Proceedings of The 4th Vietnam conference on Radio-Electronics			Vol. 1 P.175	11/1992
7	An electronic differential thermometer for medical applications	3	Có	Proceedings of The 4th Vietnam conference on Radio-Electronics			Vol. 1 P.222	11/1992
8	Pseudo-Zeeman factors for transition ions in silicon	3	Có	Proceedings of The 10th Feofilov symposium on spectroscopy of crystals activated by rare-earth and transitional-metal ions (SPIE)			Vol. 2706 P.305	04/1996
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								

9	Optically detected magnetic resonance studies of intrinsic defects in 6H-SiC	8	Không	Semiconductor Science and Technology, ISSN:0268-1242	Có - SCI IF: 2,352 Q1	39	Vol.14 P.1141-1146	09/1999
10	Electron paramagnetic resonance studies of defects in electron-irradiated p-type 4H and 6H SiC	9	Không	Physica B, ISSN:0921-4526	Có - SCI IF: 2,436 Q2	13	Vol.273-274 P.655-658	10/1999
11	Hole effective masses in 4H SiC.	6	Không	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI IF: 4,036 Q1	61	Vol. 61, (16), R10 544-R10 546	04/2010
12	Direct Determination of Electron Effective Mass in GaAsN/GaAs Quantum Wells	5	Có	Applied Physics Letters, ISSN:0003-6951	Có - SCI IF: 3,791 Q1	229	Vol. 77, Number 12, P. 1843-1845	09/2000

13	Ga-related defect in as-grown Zn-doped GaN: An optically-detected magnetic resonance study	6	Có	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI IF: 4,06 Q1	12	Vol.62, number 16, P. 607-609	10/2000
14	Mechanism for rapid thermal annealing in undoped GaN _x As _{1-x} /GaAs structures grown by molecular beam epitaxy	8	Không	Applied Physics Letters, ISSN:0003-6951	Có - SCI IF: 3,791 Q1	118	Vol.77, number 15 P.2325-2327	10/2000
15	Type I Band Alignment in the GaNAs/GaAs quantum wells	6	Không	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI IF: 4,06 Q1	90	Vol.63 P.033303-1-033303-4	12/2000
16	Signature of an intrinsic point defect in GaNAs	6	Không	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI IF: 4,06 Q1	63	Vol.63 P.033203-(1-4)	02/2001

17	Properties of GaAsN/GaAs quantum wells studied by optical detection of cyclotron resonance	6	Không	Materials Science and Engineering B, ISSN:0921-5107	Có - SCI IF: 4,051 Q1	7	Vol.82 P. 218–220	04/2001
18	Spins and microstructure of hydrogenated amorphous carbon: A multiple frequency electron paramagnetic resonance study	6	Không	Applied Physics Letters, ISSN:0003-6951	Có - SCI IF: 3,791 Q1	34	Vol.78 P.2843-2845	03/2001
19	Silicon antisite in 4H SiC	3	Không	Physical Review Letters, ISSN:0031-9007	Có - SCI IF: 9,161 Q1		Vol. 87 P.045502(1-4)	07/2001
20	Carbon vacancy-related defect in 4H and 6H SiC	3	Không	Physical Review B, ISSN:2469-9950	Có - SCI IF: 4,06 Q1	127	Vol. 63, P.201201 (1-4)	04/2001
21	Evidence for type I band alignment in GaNAs/GaAs quantum structures by optical spectroscopies	6	Không	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, ISSN:1386-9477	Có - SCI IF: 3,382 Q2	3	Vol.13(2–4) P.1074-1077	02/2002

22	Fast Synthesis of PbS Nanoparticles for Fabrication of Glucose Sensor with Enhanced Sensitivity	9	Không	Journal of Electronic Materials, ISSN:0361-5235	Có - SCI IF: 1,566 Q2	4	Vol. 46 No 6 Pages 3674 - 3680	01/2017
23	Effect of annealing temperature on morphology and structure of CuO nanowires grown by thermal oxidation method	13	Không	Journal of Crystal Growth, ISSN:0022-0248	Có - SCI IF: 1,742 Q2	10	Vol. 505, Pages 33	01/2019
24	Phase transition of LaMnO ₃ nanoparticles prepared by microwave assisted combustion method	10	Không	Materials Science in Semiconductor Processing, ISSN:1369-8001	Có - SCI IF: 3,927 Q2	11	Vol. 89, Pages 121 – 125	03/2019

25	Enhanced optical properties of ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles for self cleaning surface enhanced Raman applications	11	Không	Applied Surface science, ISSN:0169-4332	Có - SCI IF: 6,707 Q1	32	Vol.505, P.144593	01/2020
26	Facile fabrication of sensitive surface enhanced Raman scattering substrate based on CuO/Ag core/shell nanowires	13	Không	Applied Surface Science, ISSN:0169-4332	Có - SCI IF: 6,707 Q1	14	Vol.509, P.145325(1)-145325(7)	01/2020
27	Sr doped LaMnO ₃ nanoparticles prepared by microwave combustion method: a recyclable visible light photocatalyst	10	Không	Results in Physics, ISSN:2211-3797	Có - SCI IF: 4,476 Q2	5	Vol.19, P.103417	09/2020

28	Efficient surface enhanced Raman scattering substrates based on complex gold nanostructures formed by annealing sputtered gold thin films	11	Không	Optical Materials, ISSN:0925-3467	Có - SCI IF: 3,080, Q2	2	Vol.121, P.111488	08/2021
29	Mesoporous TiO ₂ electron transport layer engineering for efficient inorganic-organic hybrid perovskite solar cells using hydrochloric acid treatment	9	Không	Thin Solid Films, ISSN:0040-6090	Có - SCI IF: 2,183 Q2	2	Vol.732, P. 138768	06/2021

30	Highly sensitive characteristic of surface enhanced Raman scattering for CuO/Au core/shell nanowires substrate	11	Có	Ceramics International, ISSN:0272-8842	Có - SCI <i>IF: 4.527</i> <i>Q1</i>		Vol.48, P.3199–3205	01/2022
31	Effect of annealing on the properties of transparent conducting Ag doped ZnO thin films prepared by r.f. magnetron sputtering method	11	Có	Micro and Nanostructures, ISSN:2773-0123	Có - SCI <i>IF: 2,658</i> <i>Q2</i>		Vol.166, P.07219	03/2022
32	Hole effective masses in 4H SiC determined by optically detected cyclotron resonance.	7	Không	Materials Sciences Forum, ISSN:1662-9752	Có - Scopus <i>IF: Q3</i>	7	Vols. 338- 342 P.563- 566	04/2000

33	The carbon vacancy pair in 4H and 6H SiC	7	Không	Materials Sciences Forum, ISSN:1662-9752	Có - Scopus IF: Q3	6	Vols. 338-342, P.821-824	04/2000
34	Intrinsic defects in silicon carbide polytypes	3	Không	Materials Science Forum, ISSN:1662-9752	Có - Scopus IF: Q3	3	Vol.353-356 P.499-504	12/2001
35	Synthesis of ZnO/Au nanorods for self cleaning applications	11	Có	Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ISSN:1533-4899	Có - Hệ thống CSDL quốc tế khác	3	Vol.21 (4), P.2621-2625	04/2021
36	Structural and Optical Properties of ZnSe Nanoparticles	4	Không	Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ISSN:1533-4899	Có - Hệ thống CSDL quốc tế khác	3	Vol.21 P.2582-2587	04/2021
37	Preparation of ZnO:Ga films by sol-gel method	4	Không	VNU, Journal of Science, Mathematics-Physics, ISSN:2615-9341			T. XIX, No4, P.25-30	04/2003
38	Photoluminescence of Eu-doped nano ZnO films	4	Không	VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, ISSN:2615-9341			T. XXII, No2AP, P.56	03/2006

39	Optical Properties of PbS and Au-PbS Core-Shell Nanoparticles	3	Không	VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, ISSN:2615-9341			Vol.33, No3, P.11-16	09/2017
40	Synthesis and Optical Properties of Cu ₂ O and Au-Cu ₂ O core-shell particles	3	Không	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, ISSN:2615-9341			Vol. 33, No. 4, P. 73-79	10/2017
41	Characteristics of Ag doped ZnO thin films prepared by sputtering method	4	Không	VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, ISSN:2615-9341			Vol.35, No. 4 P.87 - 92	10/2019
42	Preparation of ZnO nanoflowers for surface enhance Raman scattering applications	10	Không	VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, ISSN:2615-9341			Vol. 36, No. 1, P.1-6	01/2020
43	Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Ag	6	Không	Tạp chí đại học Đồng Nai, ISSN:2354-1482			Vol. 16, P.129 - 134	05/2020

44	Effect of annealing temperature on Cu ₂ O thin films prepared by thermal oxidation method	7	Có	VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, ISSN:2615-9341			Vol. 36, No. 2 P.31-36	06/2020
45	Fabrication of Ba doped LaMnO ₃ nanomaterials by microwave combustion method	7	Không	VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, ISSN:2615-9341			Vol. 36, No.4, P.1-9	06/2020
46	Nghiên cứu cấu trúc của màng ZnO:Ag chế tạo bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron	8	Không	Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Duy Tân, ISSN:1859-4905			Vol.4(47), P.32-36	05/2021
47	Synthesis of ZnSe nanocrystals for solid – state lighting applications	5	Không	Communications in Physics, ISSN:0886-3166			Vol. 31, No. 1, pp. 85-93	01/2021

48	Optical and electronic properties of GaNAs/GaAs structures	8	Không	Proceedings Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials and Devices, COMMAD 2000				05/2000
49	Optical investigation of Eu-doped ZnO thin films by sol-gel deposition	6	Có	Proceedings of the 5th Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue			P.228-231	02/2002
50	Sol-gel preparation of highly-oriented ZnO thin films.	6	Không	Proceedings of the 5th Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue			P.232-235	02/2002
51	Optical investigation of Eu-doped ZnO powder prepared by sol-gel method.	6	Có	Proceedings of 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics, 2-3 November 2002			P.290-293	11/2002
52	ZnO Films: Formation Process and Optical Properties.	3	Không	Proceedings of the 3rd National Conference on Optics and Spectroscopy, Modern Problems in Optics and Spectroscopy			P.263-270	08/2002

53	Fabrication of poly-Si thin film transistor using gate oxide layer formed by wet ozone-enriched oxidation.	5	Không	Digest of Tech. Papers IWD'03			AMDp-19, P.447-450	05/2003
54	Characteristics of MOS structure formed by the humid gas mixture of O ₂ +O ₃ at low temperature.	5	Có	Digest of Tech. Papers AM-LCD'03			TFTp1-2, P.91-94	06/2003
55	Enhancement of silicon oxide growth at low temperature by pre-heated humid ozone-enriched gas.	4	Có	Digest of Tech. Papers AM-LCD'04			TFTp2-L1, P.197	06/2004
56	Silicon oxide formation for TFTs using humid ozone-enriched gas ambient at low temperature.	3	Có	Proceeding of the 34th European Solid-state Device Research Conference (ESSDERC 2004)			P.313	06/2004

57	Nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO và ZnO pha tạp Eu chế tạo tại nhiệt độ và áp suất cao	3	Có	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009			P. 259-262.	11/2009
58	Pulse electron deposition of LaMnO3 thin films with taret made of LaMnO3 nanopowder synthesized by self combustion method	12	Không	Proceedings of IWNA 2017, 08-11 November 2017, Phan Thiet, Vietnam.				11/2017
59	Facile fabrication of gold nanoparticles by sputtering methods	9	Không	Proceedings IWNA 2019, November 06-09			NFT-025 – P	11/2019
60	Surface enhance Raman scattering of methylene Blue adsorbed on gold nanoparticles	9	Không	Proceedings IWNA 2019, November 06-09			AMN-044 – P	11/2019

61	Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano LaMnO ₃ pha tạp Sr có độ xốp lớn	5	Có	Hội nghị Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERDS 2020			P.39-43	11/2020
----	--	---	----	--	--	--	---------	---------

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 5 ([12] [13] [30] [31] [35])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS:

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng

quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)